(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1

(43) 国際公開日 2005 年3 月3 日 (03.03.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/020223 A1

(51) 国際特許分類⁷: G11B 7/24, 7/26, 7/00, B41M 5/26

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/011857

(22) 国際出願日:

2004年8月12日(12.08.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-298329

2003年8月22日(22.08.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): TDK 株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都 中央区 日本橋一丁目 1 3 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菊川 隆

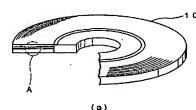
(KIKUKAWA,Takashi) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号TDK株式会社内 Tokyo (JP). 福澤 成敏 (FUKUZAWA,Narutoshi) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号TDK株式会社内Tokyo (JP). 小林龍弘(KOBAYASHI,Tatsuhiro) [JP/JP]; 〒103-8272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号TDK株式会社内Tokyo (JP).

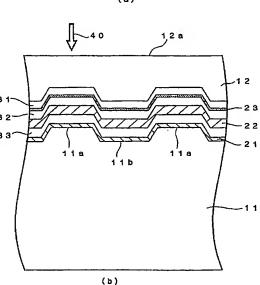
- (74) 代理人: 内藤 照雄 , 外(NAITO,Teruo et al.); 〒107-6012 東京都 港区 赤坂一丁目 1 2番 3 2号 アーク森 ビル 1 2階 信栄特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

(54) Title: OPTICAL RECORDING MEDIUM AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, DATA RECORDING METHOD AND DATA REPRODUCING METHOD FOR OPTICAL RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 光記録媒体及びその製造方法、並びに、光記録媒体に対するデータ記録方法及びデータ再生方法





(57) Abstract: An optical recording medium comprising a supporting substrate (11), a light transmission layer (12); and a dielectric layer (31), a noble metal oxide layer (23), a dielectric layer (32), a light absorption layer (22), and a dielectric layer (33) arranged in this order, when viewed from the side of the light transmission layer (12), between the light transmission layer (12) and the supporting substrate (11). The light absorption layer (22) can be expressed as (Sb_aTe_{1-a})_{1-b}MA_b (where, MA is an element other than antimony (Sb) and tellurium (Te), and 0<a<1, 0 leq b<1), and principally contains a material different from an intermetallic compound expressed as {(GeTe)_c(Sb₂Te₃)_{1-c}}_dMB_{1-d} (where, MB is an element other than antimony (Sb), tellurium (Te), and germanium (Ge) and c=1/3, 1/2 or 2/3, 0<d leq 1).

(57) 要約: 支持基板11と、光透過層12と、光透過層12と支持基板11との間に光透過層12から見てこの順に配置された誘電体層31、貴金属酸化物層23、誘電体層32、光吸収層22及び誘電体層33とを備える。光吸収層22は、(Sb_aTe_{1-a})_{1-b}MA_b(但し、MAはアンチモン(Sb)及びテルル(Te)を除く元素であり、0<a<1であり、0≦b<1である)で表すことができ、且つ、{(GeTe)_c(Sb₂Te₃)_{1-c})_dMB_{1-d}(但し、MBはアンチモン(Sb)、テルル(Te)及びゲルマニウム(Ge)を除く元素あり、c=1/3、1/2又は2/3であり、0<d≦1である)で表される金属間化合物とは異なる材料を主成分とする。

NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。